

**Verwendung:** Germanium-pnp-Hochfrequenztransistor für Verstärkerstufen bei 37 MHz bei Umgebungstemperaturen bis +65 °C

**GF 128**

**Abmessungen:** Bauform A 4/15 – 4 b,

TGL 11 811

Masse  $\approx 0,6$  g

**Zulässige Höchstwerte**

für  $\theta_a = 45^\circ\text{C}$

-UCBO = 25 V

-UEBO = 0,5 V

-UCER = 20 V

bei  $\frac{R_B}{R_E} = \leq 100$

mit  $R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

-Ic = 10 mA

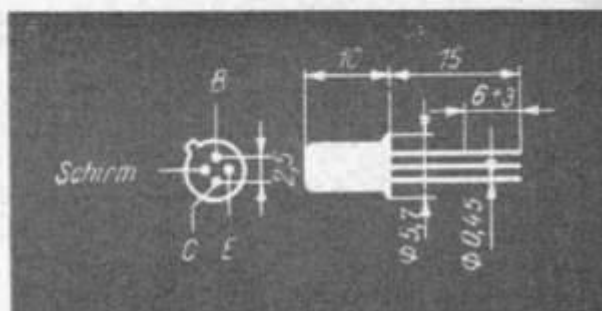
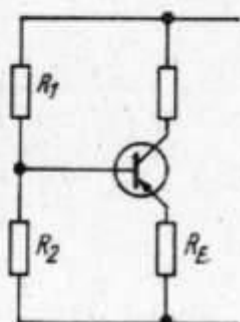
I<sub>E</sub> = 11 mA

-I<sub>B</sub> = 1 mA

P<sub>tot</sub> = 50 mW

$\theta_j = 75^\circ\text{C}$

$\theta_a = 65^\circ\text{C}$



**Kennwerte** für  $\theta_a = 25^\circ\text{C} - 5$  grad

**Wärmewiderstand**  $R_{th} \leq 0,6 \frac{\text{grad}}{\text{mW}}$

	Min	Typ	Max	Meßbedingungen
--	-----	-----	-----	----------------

**Restströme**

-I <sub>CBO</sub>			7,5 $\mu\text{A}$	-U <sub>CB</sub> = 6 V
-I <sub>CBO</sub>			100 $\mu\text{A}$	-U <sub>CB</sub> = 25 V
-I <sub>EBO</sub>			100 $\mu\text{A}$	-U <sub>EB</sub> = 0,5 V

**Übergangsfrequenz**

f <sub>T</sub>	100 MHz			-U <sub>CE</sub> = 10 V, -I <sub>c</sub> = 3 mA, f = 100 MHz
----------------	---------	--	--	--

Min

Typ

Max

Meßbedingungen

## Vierpolparameter

$g_{11e}$	5 mS	11 mS	25 mS	$-U_{CE} = 10 \text{ V}, -I_C = 3 \text{ mA}, f = 37 \text{ MHz}$
$C_{11e}$	12 pF	30 pF	80 pF	
$Y_{21e}$	40 mS	60 mS		
$g_{22e}$	83 $\mu\text{S}$	160 $\mu\text{S}$	360 $\mu\text{S}$	
$C_{22e}$	1,5 pF	2,5 pF	4,5 pF	

## Kollektor-Rückwirkungszeitkonstante

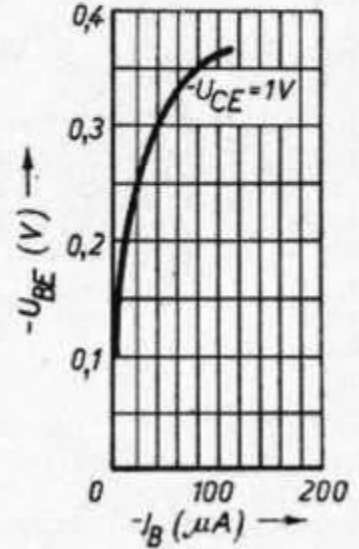
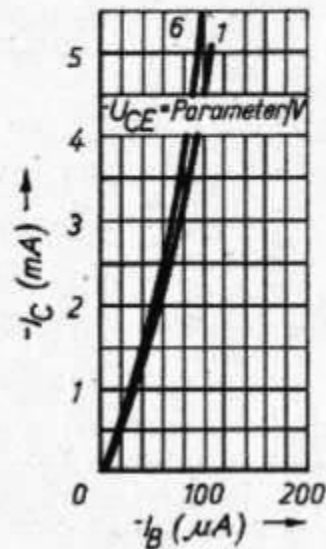
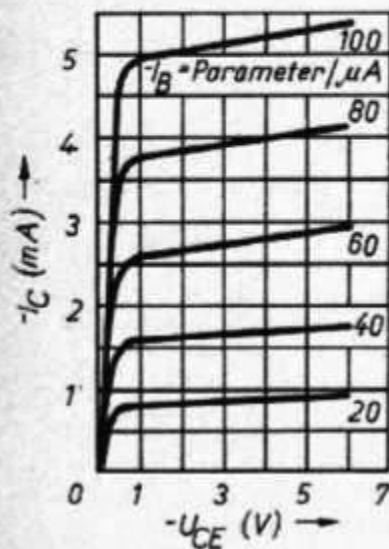
$\frac{h_{12b}}{\omega}$		24 ps	$-U_{CB} = 10 \text{ V}, -I_C = 3 \text{ mA}, f = 30 \text{ MHz}$
--------------------------	--	-------	---

## Gleichstromverstärkung

B	40		$-U_{CE} = 6 \text{ V}, -I_C = 1 \text{ mA}$
---	----	--	--

## Bestellbeispiel für einen Transistor

## Transistor GF 128

Mittlere Kennlinien für  $\theta_a = 25^\circ\text{C}$ 

# Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur

- Grenzwert
- Mittelwert

